# 結晶シリコン太陽電池モジュールにおける寿命評価指標の探索

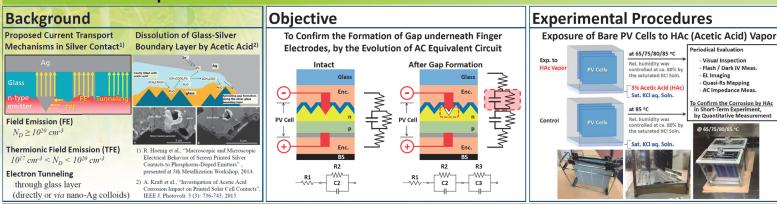
<mark>棚橋 紀悟¹•坂本憲彦²•柴田肇³•増田淳¹</mark>

產業技術総合研究所

太陽光発電研究センター 1モジュール信頼性チーム・3化合物薄膜チーム 2応用電気標準研究グループ 計量標準総合センター

Panel 3: SEM & EPMA Images

### **Introduction & Experimental Procedures**



#### Summary

- 結晶シリコン太陽電池セルを酢酸蒸気に曝露することにより、集電能力の低下の原因となる フィンガ電極下のギャップ形成を確認 (Panel 1-4)。
- このギャップ形成にともなう(大幅な)FFの低下と、それに同期した新たな交流インピーダンス成 分 (R3/C3)の発現・変動を確認 (Panel 5-8)。
- ・ 酢酸蒸気曝露による結晶シリコン太陽電池セルの発電特性低下は、2段階で進行している点を 確認 (Panel 8)。右図に示す劣化機構を推定している。

Phase I: FF低下・R3/C3の発現と変動 Phase II: Isc低下

両者は、異なる反応機構で進行している模様(Ea の差異: Panel 9)。

DH試験に供したPVモジュールにおいても、酢酸蒸気曝露したPVセルと同様の劣化状況を確認。 R3などは、PVモジュール寿命推定に有用なインデックス("Aging Signature")となる可能性あり。

Panel 2: EL & Quasi-Rs Images

# Putative Degradation Process on c-Si PV Cells Exposed to HAc Finger Electrode Emitte (Si) FF Decreasing Isc Decreasing "Constellation" on PV Cell: Bright Spots are Only on Finger Electrodes

Panel 4: SEM & EPMA Images

## Results

 $y = \frac{1}{1 + (x/c)^b}$ Pmax @Phase I

2.8E-03 2.9E-03 1 / T [1/K]

Panel 1: Flash IV Characteristics

